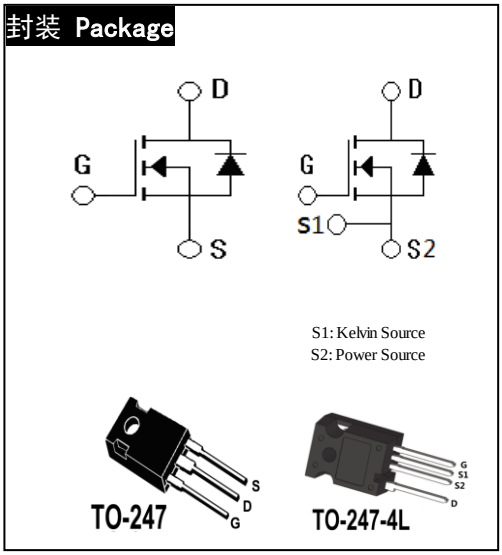
MS65R037AR

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_D	75A
V_{DSS}	650 V
Rdson-max (@Vgs=10V)	37 mΩ
Qg-typ	178 nC

封装 Package



用途

- 高频开关电源
- 电子镇流器
- LED 电源

APPLICATIONS

- High frequency switching mode power supply
- Electronic ballast
- LED power supply

产品特性

- 低栅极电荷
- 开关速度快
- 产品全部经过雪崩测试
- 高抗 dv/dt 能力
- RoHS 产品
- 超结产品

FEATURES

- Low gate charge
- Fast switching
- 100% avalanche tested
- Improved dv/dt capability
- RoHS product
- Super Junction MOS

订货信息 ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes				印 记 Marking	封 装 Package
有卤-条管	无卤-条管	有卤-编带	无卤-编带		
Halogen-Tube	Halogen-Free-Tube	Halogen-reel	Halogen-Free-Reel		
MS65R037AR-GE-B	MS65R037AR -GE-BR	N/A	N/A	MS65R037AR	TO-247
MS65R037AR-GH-B	MS65R037AR-GH-BR	N/A	N/A	MS65R037AR	TO-247-4L

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最高漏极－源极直流电压 Drain-Source Voltage	V_{DSS}	650	V
连续漏极电流 Drain Current -continuous	I_D T=25℃	75*	A
	T=100℃	48*	A
最大脉冲漏极电流（注 1） Drain Current - pulse （note 1）	I_{DM}	230*	A
最高栅源电压 Gate-Source Voltage	V_{GSS}	±30	V
单脉冲雪崩能量（注 2） Single Pulsed Avalanche Energy（note 2）	E_{AS}	600	mJ
二极管反向恢复最大电压变化速率（注 3） Peak Diode Recovery dv/dt （note 3）	dv/dt	50	V/ns
MOSFET dv/dt 抗冲击能力 （注 3） MOSFET dv/dt ruggedness （note 3）	dv/dt	40	V/ns
耗散功率 Power Dissipation	P_D T_C=25℃	430	W
	-Derate above 25℃	3.44	W/℃
最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55～+150	℃
引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes	T_L	300	℃

*漏极电流由最高结温限制

*Drain current limited by maximum junction temperature

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项　　目 Parameter	符　号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最 大 Max	单 位 Units
关态特性 Off －Characteristics						
漏一源击穿电压 Drain-Source Voltage	BV_{DSS}	I_D=250μA, V_{GS}=0V	650	－	－	V
击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$\Delta BV_{DSS}/\Delta T_J$	I_D=250μA, referenced to 25℃	－	0.65	－	V/℃
零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS}=650V, V_{GS}=0V, T_C=25℃	－	－	10	μA
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	I_{GSSF}	V_{DS}=0V, V_{GS} =30V	－	－	100	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	I_{GSSR}	V_{DS}=0V, V_{GS} =-30V	－	－	-100	nA
通态特性 On-Characteristics						
阈值电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS} = V_{GS} , I_D=250μA	3	3.5	4	V
静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(ON)}$	VGS =10V, ID=30A, Tj=25℃	－	33	37	mΩ
		VGS =10V, ID=30A, Tj=150℃	－	80	－	
动态特性 Dynamic Characteristics						
输入电容 Input capacitance	C_{iss}	V_{DS}=50V, V_{GS} =0V, f=250KHz	－	4200	－	pF
输出电容 Output capacitance	C_{oss}		－	130	－	pF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	C_{rss}		－	3.2	－	pF
栅极电阻 Gate Resistance	RG	f=1MHz	－	4	－	Ω

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

开关特性 Switching Characteristics						
延迟时间 Turn-On delay time	$t_{d(on)}$	V_{DD}=400V, I_D=30A, R_G=3.3 Ω , VGS=12V （note 3, 4）	–	25	–	ns
上升时间 Turn-On rise time	t_r		–	21	–	ns
延迟时间 Turn-Off delay time	$t_{d(off)}$		–	110	–	ns
下降时间 Turn-Off Fall time	t_f		–	4	–	ns
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Q_g	V_{DS} =400V , I_D=30A V_{GS} =0 to10V （note 3, 4）	–	178	–	nC
栅－源电荷 Gate-Source charge	Q_{gs}		–	25	–	nC
栅－漏电荷 Gate-Drain charge	Q_{gd}		–	106	–	nC
漏－源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings						
正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain -Source Diode Forward Current	I_S		–	–	75	A
正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current	I_{SM}		–	–	230	A
正向压降 Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	V_{GS}=0V, I_S=30A	–	–	1.3	V
反向恢复时间 Reverse recovery time	t_{rr}	V_{DD}=400V, I_S=30A di/dt=300A/μs (note 4)	–	110	–	ns
反向恢复电荷 Reverse recovery charge	Q_{rr}		–	1.3	–	μC
反向峰值电流 Peak reverse recovery current	I_{rrm}		–	-18	–	A

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项　目 Parameter	符　号 Symbol	最大 Max	单　位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case	Rth(j-c)	0.29	℃/W
结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient	Rth(j-A)	62	℃/W

注释：

1：脉冲宽度由最高结温限制

2：L=50mH, V_{DD}=50V, R_G=25 Ω,VG=10V 起始结温 T_J=25℃

3：I_{SD}≤75A, di/dt≤300A/μs, VDD≤BV_{DSS}, RG=4Ω, VGS=30V,起始结温 T_J=25℃

4：脉冲测试：脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%

5：基本与工作温度无关

Notes:

1: Pulse width limited by maximum junction temperature

2: L = 50mH, VDD = 50V, RG = 25Ω, VG=10V, Starting TJ = 25° C

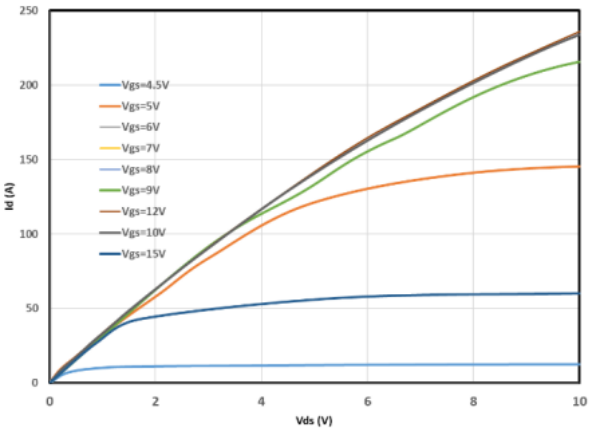
3:ISD ≤ 75A, di/dt ≤ 300A/μs, VDD ≤ BVDSS, RG = 4Ω, VGS = 30V, initial junction temperature TJ = 25℃

4: Pulse Test: Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2%

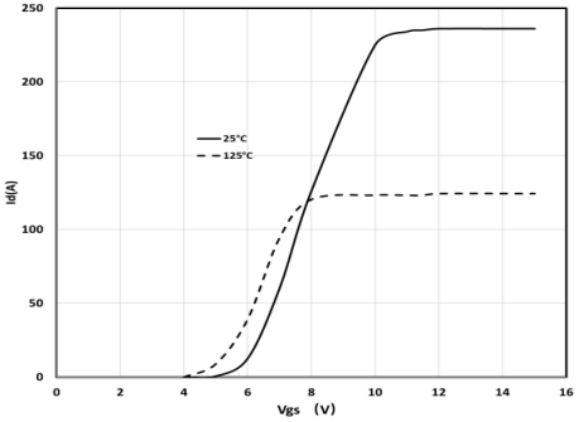
5: Essentially independent of operating temperature

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

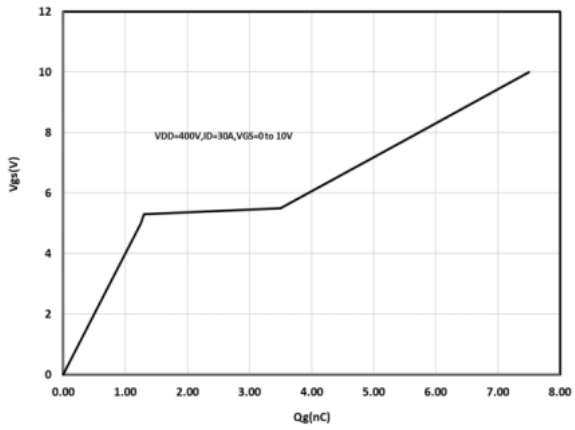
On-Region Characteristics



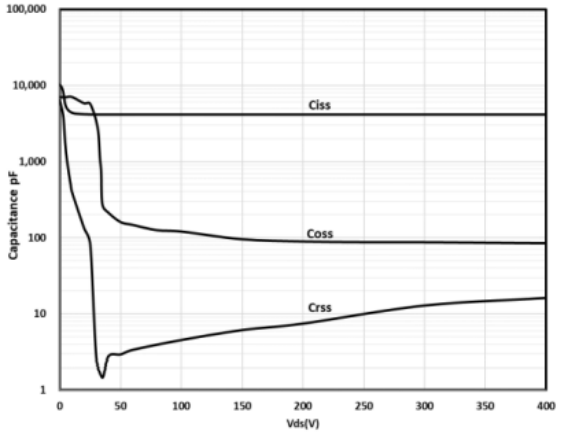
Transfer Characteristics



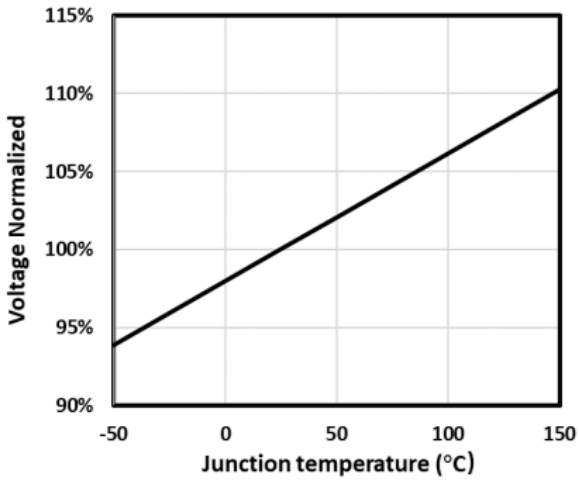
Gate Charge Characteristics



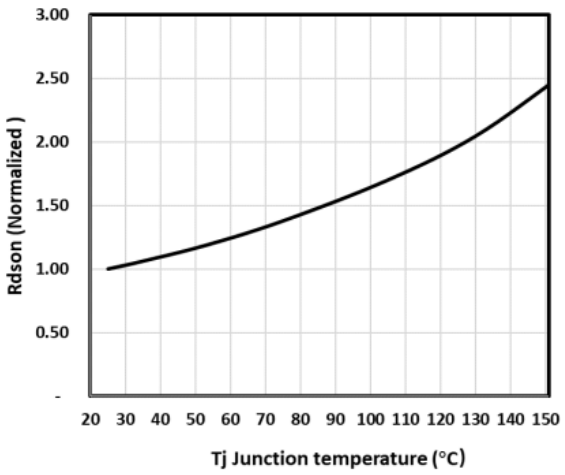
Capacitance Characteristics



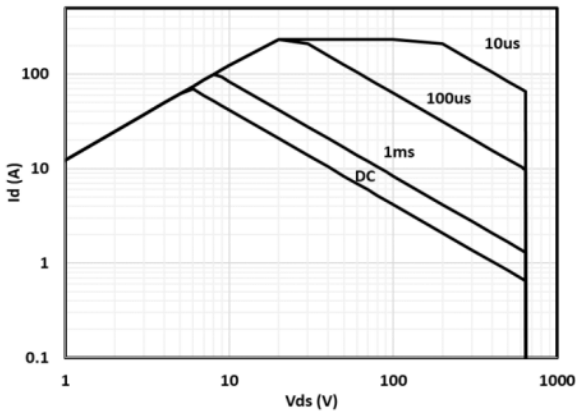
Breakdown Voltage Variation vs. Temperature



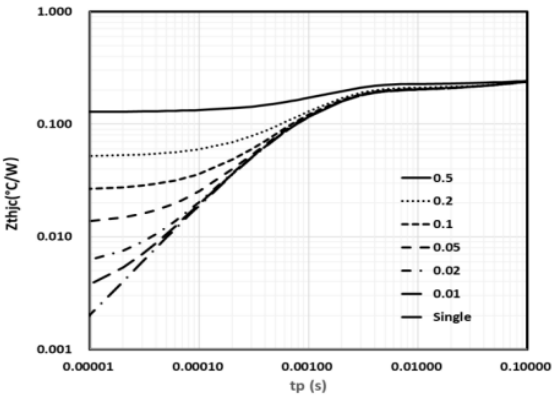
On-Resistance Variation vs. Temperature



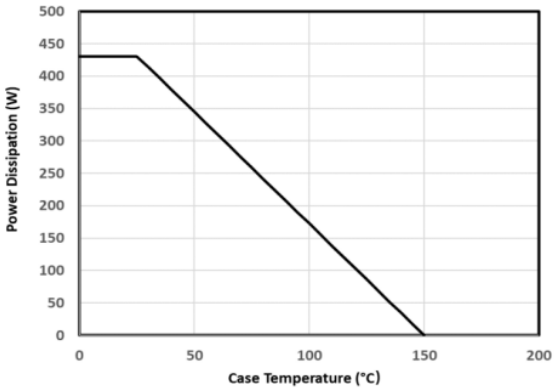
Maximum Safe Operating Area For MS65R037AR/TO-247



Transient Thermal Response Curve For MS65R037AR/TO-247



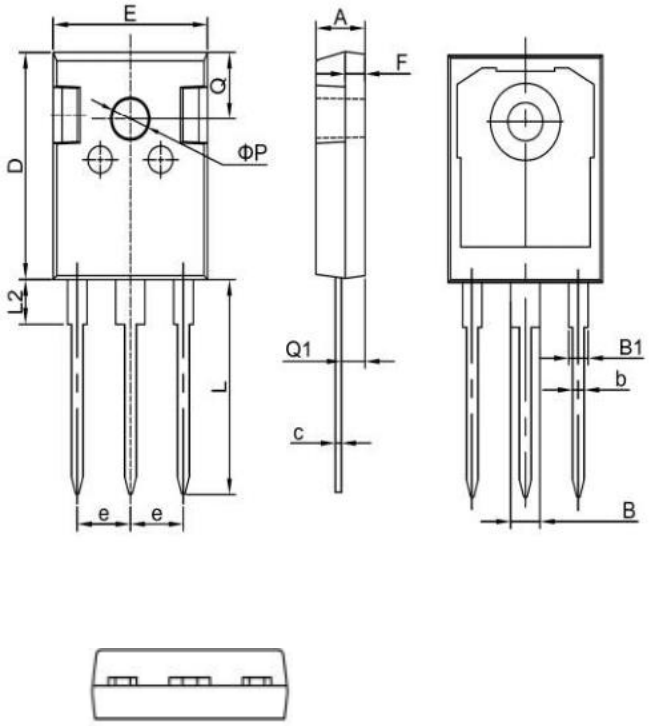
Power Disspation vs. Temperature



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-247

单位 Unit：mm

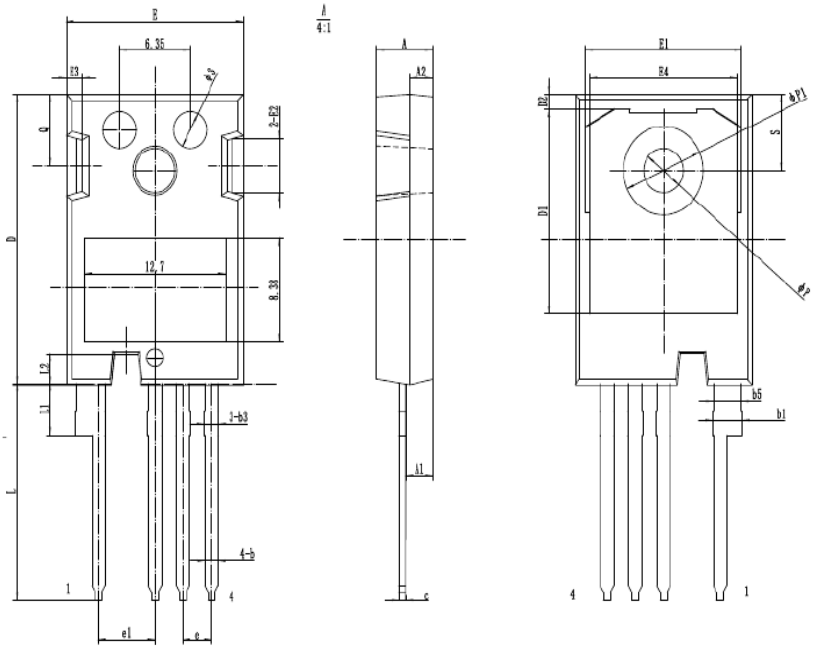


符号 symbol	MIN	MAX
A	4.90	5.10
B	2.95	3.35
B1	1.95	2.35
b	1.15	1.35
c	0.50	0.70
D	20.90	21.10
E	15.70	15.90
e	5.34	5.54
F	1.90	2.10
L	19.40	20.40
L2	4.03	4.23
Q	6.00	6.40
Q1	2.30	2.50
P	3.50	3.70

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-247-4L

单位 Unit：mm



SYMBOL	mm		
	MIN	NOM	MAX
*A	4.83	5.02	5.21
A1	2.29	2.41	2.54
A2	1.91	2.00	2.16
*b	1.07	1.20	1.33
b1	2.39	2.67	2.94
b3	1.07	1.30	1.60
b5	2.39	2.53	2.69
*c	0.55	0.60	0.68
*D	23.30	23.45	23.60
D1	16.25	16.55	17.65
D2	0.95	1.19	1.25
*E	15.75	15.94	16.13
E1	13.10	14.02	14.15
E2	3.68	4.40	5.10
E3	1.00	1.45	1.90
E4	12.38	13.26	13.43
*e		2.54BSC	
e1		5.08BSC	
*L	17.31	17.57	17.82
*L1	3.97	4.19	4.37
*L2	2.30	2.50	2.65
*øP	3.51	3.61	3.65
*øP1		7.19REF	
*Q	5.49	5.79	6.00
S	6.04	6.17	6.30

注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don’t be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司
公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号
邮编：132013
总机：86-432-64678411
传真：86-432-64665812
网址：www.hwdz.com.cn

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.
Post Code: 132013
Tel： 86-432-64678411
Fax：86-432-64665812
Web Site：www.hwdz.com.cn